

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

2SA484, 2SA485

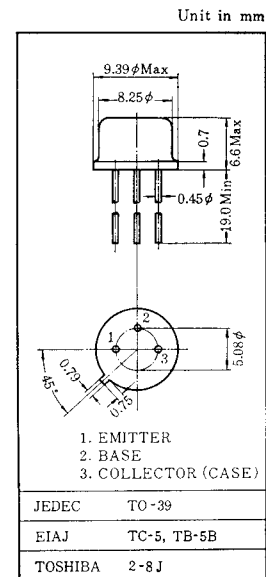
○電力増幅用

○ Medium Power Amplifier Applications.

- 耐圧が高い $V_{CEO} = -110V$ 2SA484
 $V_{CEO} = -80V$ 2SA485
- 2SC484, 2SC485 とコンプリメンタリで高出力 Hi-Fi アンプの励振段に適します。
- Complementary to 2SC484 and 2SC485 Suitable for Driver Amplifier of High Power Hi-Fi System.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	2SA484 V_{CBO}	-110	V
	2SA485	-80	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SA484 V_{CEO}	-110	V
	2SA485	-80	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	A
エミッタ電流	I_E	1.5	A
コレクタ損失	P_C	800	mW
接合温度	T_J	175	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~175	$^\circ C$



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -30V, I_E = 0$	—	—	-10	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SA484 $V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-110	—	—	V
	2SA485		-80	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -0.1mA, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE} = -2V, I_C = -200mA$	30	80	300	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	2SA484 $V_{CE(sat)}$	$I_C = -1A, I_B = -0.1A$	—	—	-2.2	V
	2SA485		—	—	-1.8	
ベース・エミッタ間電圧	2SA484 V_{BE}	$V_{CE} = -2V, I_C = -500mA$	—	—	-1.6	V
	2SA485		—	—	-1.4	
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_E = 30mA$	—	20	—	MHz

Note: h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} , the 2SA484 and 2SA485 are classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA484—R 2SA485—R	30	85
2SA484—Y 2SA485—Y	50	140
2SA484—BL 2SA485—BL	100	300